

Транзисторы KT938Б-2 предназначены для работы в усилительных и генераторных устройствах на частоте до 5 GHz, в составе гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы, пониженного и повышенного давления.

Si-n-p-n-EP

The KT938Б-2 transistors are designed for operation in amplifiers and oscillators at frequencies up to 5 GHz when used in hybrid integrated microcircuits, subassemblies and equipment which provide hermetic sealing and protection of the transistors against the effects of moisture, salt spray, mould fungi, hoarfrost and dew, low and high pressure.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{case} = -60...+100^{\circ}C$ MAXIMUM RATINGS

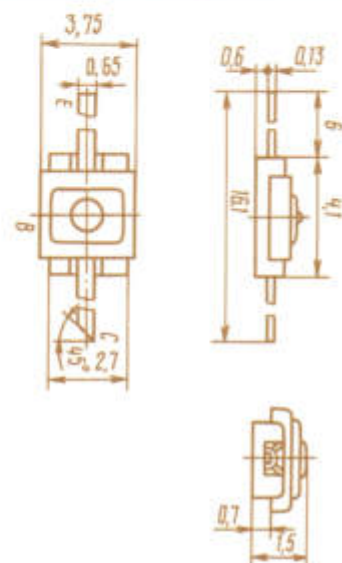
$U_{CB\ max}, V$	28
$U_{EB\ max}, V$	2,5
$I_{C\ max}, mA$	180
$P_{C\ max}^* (t_{case} \leq 30^{\circ}C), W$	1,5
$P_{C\ max}^{**} (t_{case} \leq 25^{\circ}C), W$	2,5
$t_{j\ max}, ^{\circ}C$	150

*При $t_{case} > 30^{\circ}C \Rightarrow P_{C\ max} = \frac{150 - t_{case}}{80}$

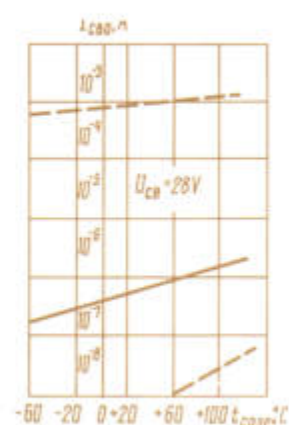
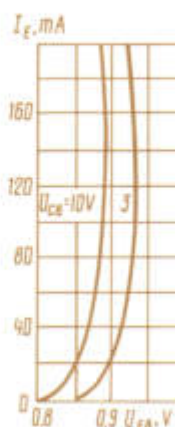
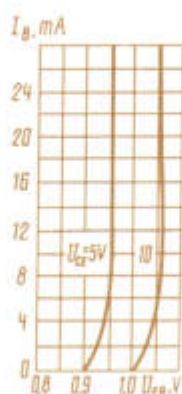
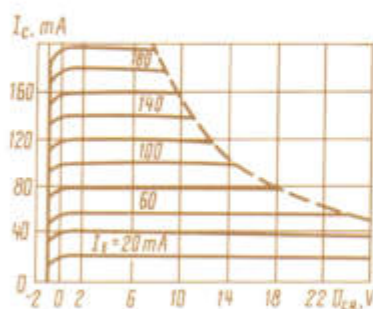
**Динамический режим.
Dynamic operation.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	KT938Б-2	Режимы Conditions
1	2	3
I_{CBO}, mA	≤ 1	$U_{CB} = 28 V$
I_{EBO}, mA	$\leq 0,1$	$U_{EB} = 2,5 V$



1	2	3
f_T, GHz	$\geq 1,8$	$U_{CE} = 3 V$ $I_C = 150 mA$ $f = 300 MHz$
τ_c	$\leq 2,5$	$U_{CB} = 10 V$ $I_E = 50 mA$ $f = 100 MHz$
C_c, pF	$\leq 4,5$	$U_{CB} = 20 V$ $f = 10 MHz$
C_e, pF	≤ 12	$U_{EB} = 2,5 V$ $f = 10 MHz$
G_p, dB	≥ 2	$P_{out} = 0,8 W$ $U_{CB} = 20 V$ $f = 5 GHz$



KT938Б-2

